

NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ (6 ピン 2 回路)

低周波増幅用

μPA604T は、トランジスタを2回路内蔵したミニモールドデバイスであり、実装密度の向上、実装コストの削減に貢献します。

特 徴

- SC-59 パッケージと同じサイズのパッケージにトランジスタを2回路内蔵
- μPA605T とコンプリメンタリで使用可能
- 自動実装対応

品質水準

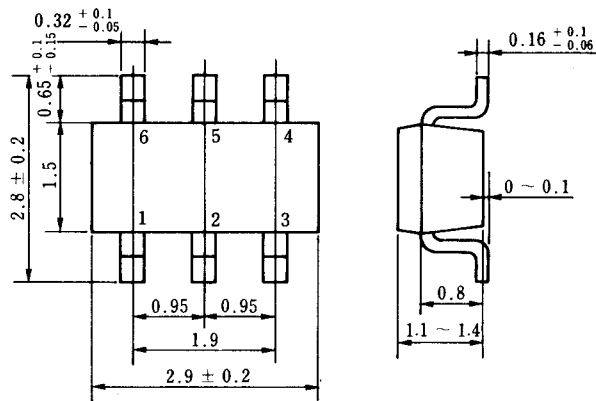
- 標準 (一般電子機器用)

品質水準とその応用分野の詳細については当社発行の資料「NEC 半導体デバイスの品質水準」(IEI-620) をご覧ください。

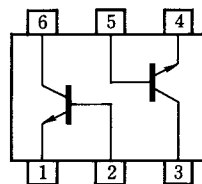
絶対最大定格 (T_a = 25 °C)

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	V _{BE} = 0	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	V _{BE} = 0	50	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	V _{CE} = 0	5.0	V
コレクタ電流 (直 流)	I _{C(DC)}		100	mA
コレクタ電流 (パルス)	I _{C(pulse)}	PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 50 %	200	mA
全 損 失	P _T		300 (TOTAL)	mW
ジャンクション温度	T _j		150	°C
保 存 温 度	T _{stg}		-55 ~ +150	°C

外形図 (単位: mm)



端子接続

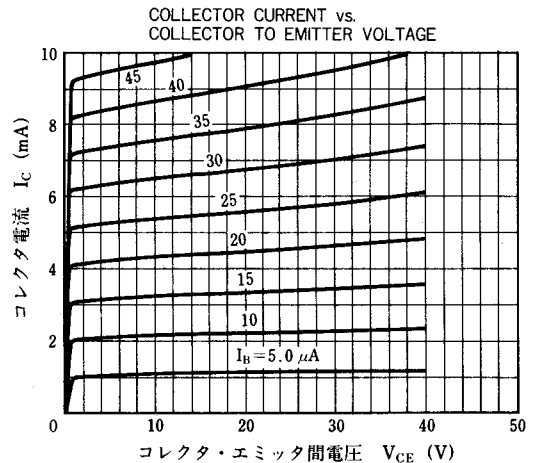
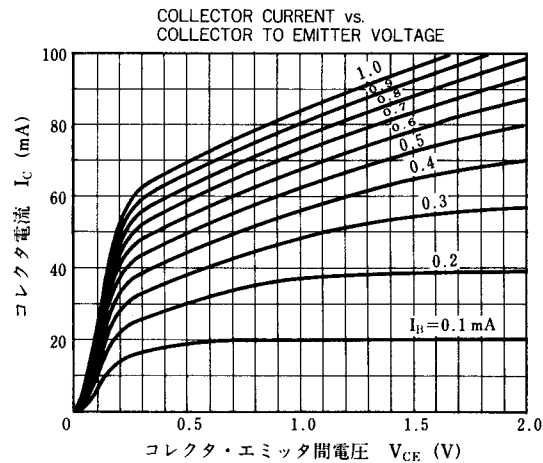
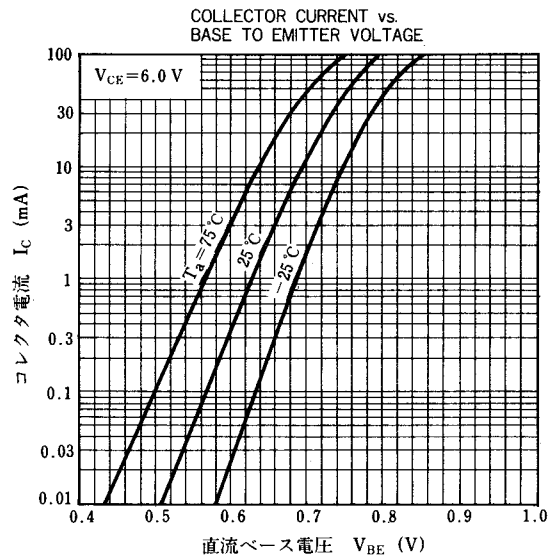
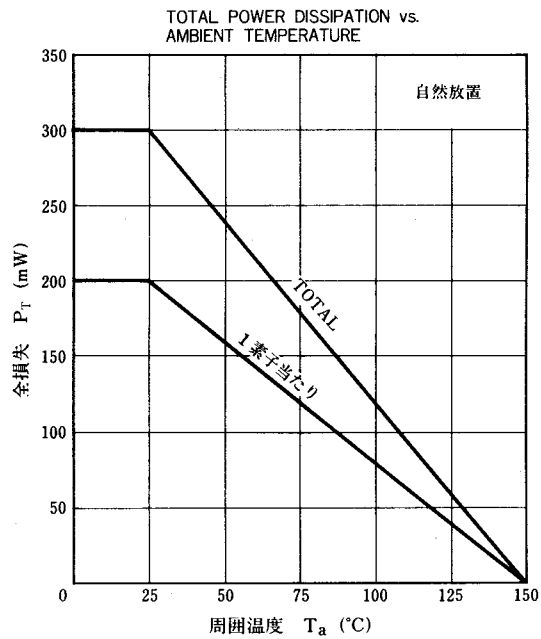


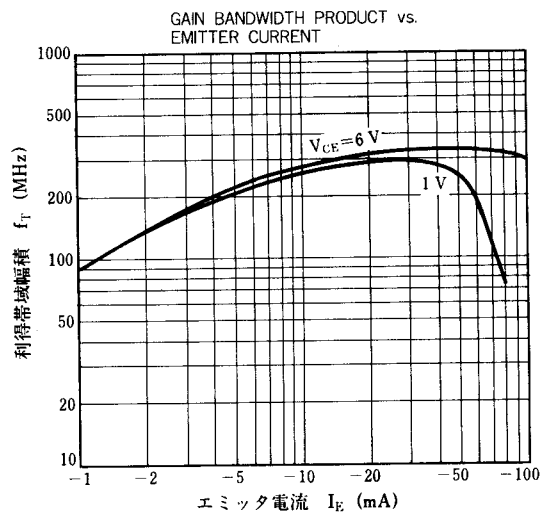
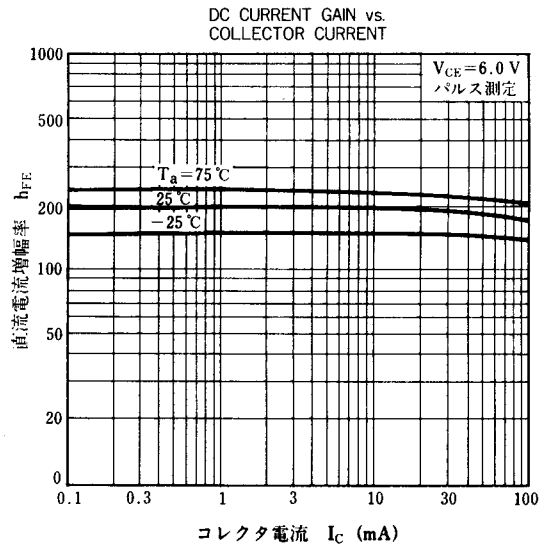
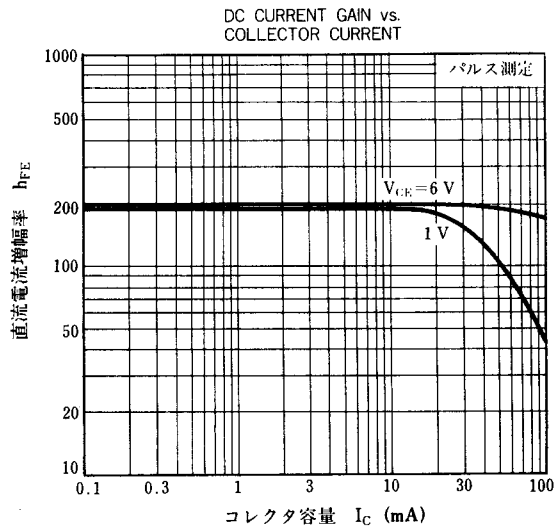
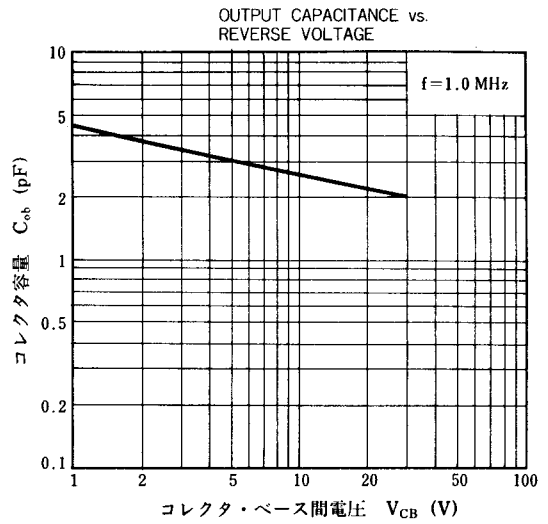
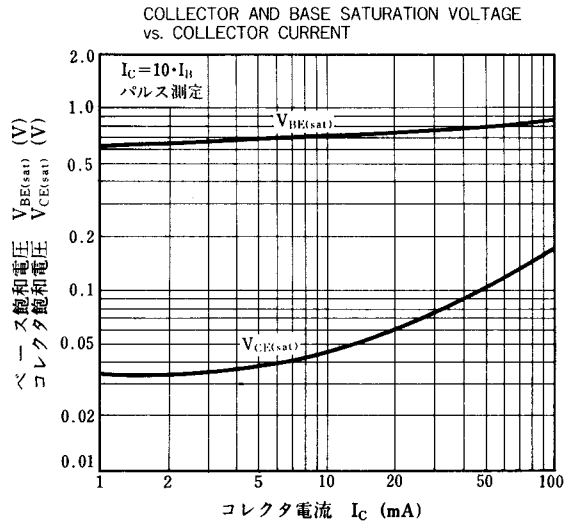
- 1. エミッタ (E1)
 - 2. ベース (B1)
 - 3. コレクタ (C2)
 - 4. エミッタ (E2)
 - 5. ベース (B2)
 - 6. コレクタ (C1)
- 捺印: KA

電気的特性 (T_a = 25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =60 V, I _E =0			100	nA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5.0 V, I _C =0			100	nA
直流電流増幅率	h _{FE1}	V _{CE} =6.0 V, I _C =0.1 mA	50			—
直流電流増幅率	h _{FE2}	V _{CE} =6.0 V, I _C =1.0 mA	90		600	—
直流ベース電圧	V _{BE(on)}	V _{CE} =6.0 V, I _C =1.0 mA		0.62		V
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =100 mA, I _B =10 mA		0.15	0.30	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =100 mA, I _B =10 mA		0.86	1.00	V
利得帯域幅積	f _T	V _{CE} =6.0 V, I _C =-10 mA	150	250		MHz
コレクタ容量	C _{ob}	V _{CB} =6.0 V, I _E =0, f=1.0 MHz		3.0	4.0	pF

特性曲線 (T_a = 25 °C)





半田付け推奨条件

本製品の半田付け実装は、下表の推奨条件で実施願います。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、販売員にご相談ください。

表面実装タイプ

半田付け推奨条件の詳細は、インフォメーション資料「半導体デバイス実装マニュアル」(IEI-616)をご参照ください。

半田付け方式	半 田 付 け 条 件	推奨条件記号
赤外線リフロ	パッケージ・ピーク温度：230℃，時間：30秒以内(210℃以上)，回数：1回 制限日数：なし*	IR30-00
VPS	パッケージ・ピーク温度：215℃，時間：40秒以内(200℃以上)，回数：1回 制限日数：なし*	VP15-00
ウェーブ・ソルダリング	半田槽温度：260℃以下，時間：10秒以内，回数：1回 制限日数：なし*	WS60-00
端子部分加熱	端子部温度：300℃以下，時間：10秒以内，制限日数：なし*	○

*：ドライパック開封後の保管日数で、保管条件は25℃，65%RH以下。

注1. 半田付け方式の併用はお避けください(ただし、端子部分加熱方式は除く)。

